1 MPC-AIO

1) TRANZISTOROVÁ ROVNICE PRO BIPOLÁRNI TRANZISTOR

- Základní výpočty s tranzistorovou rovnicí
- Sériová kombinace Vbe+Vr
- Výpočet transkonduktance
- 2) SOUBĚH (MATCHING)
- Princip technologického, litografického a teplotního souběhu
- Použití pravidel souběhu pro návrh odporového děliče
- Použití pravidel souběhu pro bipolární a MOS tranzistorovou dvojici
- 3) PROUDOVÉ ZRCADLO, PROUDOVÝ ZDROJ
- Princip proudového zrcadla s bipolárními tranzistory
- Chybové faktory proudového zrcadla
- Použití kaskódy v proudových zrcadlech
- Výpočet hodnot prvků proudového zdroje
- 4) PROUDOVÉ ZRCADLO, PROUDOVÝ ZDROJ
- Princip proudového zrcadla s MOS tranzistory
- Chybové faktory proudového zrcadla
- Použití kaskódy v proudových zrcadlech
- Výpočet hodnot prvků proudového zdroje
- 5) AKTIVNÍ ZÁTĚŽ
- Princip aktivní zátěže
- Princip elementárního proudového komparátoru
- Výpočet zisku stupně s aktivní zátěží
- 6) DIFERENCIÁLNÍ TRANZISTOROVÝ STUPEŇ
- Princip diferenciálního bipolárního tranzistorového stupně
- Výpočet transkonduktance bipolárního diferenciálního tranzistorového stupně
- Výpočet transkonduktance bipolárního diferenciálního tranzistorového stupně s emitorovou degenerací
 - 7) DIFERENCIÁLNÍ TRANZISTOROVÝ STUPEŇ
 - Výpočet zisku bipolárního diferenciálního tranzistorového stupně s odporovou zátěží
 - Diferenciální tranzistorový stupeň s aktivní zátěží
 - OTA transkonduktanční stupeň
 - Elementární komparátor s diferenciálním vstupem

8) PROUDOVÝ ZDROJ IPTAT

- Generátor dVbe napětí
- Princip proudového zdroje IPTAT " Americký" koncept
- Zpětnovazební nízkonapěťový IPTAT proudový zdroj

9) PROUDOVÝ ZDROJ IPTAT

- Generátor dVbe napětí
- Elementární zdroj Band Gap napětí
- Plovoucí Band Gap zdroj

10) OPERAČNÍ ZESILOVAČ

- Obecný jednostupňový operační zesilovač
- Jednostupňový zesilovač s vysokým ziskem
- Dvojstupňový operační zesilovač s emitorovým sledovačem

11) OPERAČNÍ ZESILOVAČ

- Buffer s jednotkovým zesílením
- Obecný koncový stupeň Rail-to-Rail
- Koncový stupeň Rail-to-Rail typu emitorový sledovač
- Operační zesilovač se stupněm typu složená kaskóda (folded cascode)

12) OPERAČNÍ ZESILOVAČ

- Princip kmitočtové kompenzace
- Kmitočtová kompenzace zpětnovazebního IPTAT proudového zdroje
- Millerova kmitočtová kompenzace, výpočet ST přenosu operačního zesilovače
- Eliminace RHP nuly

13) BAND GAP REFERENCE

- Princip Band Gap reference
- Band Gap reference podle P. Brokawa s aktivní zátěží
- Band Gap reference podle P. Brokawa s odporovou zátěží a operačním zesilovačem
- Band Gap předstabilizátor

2 MPC-DIS

- 1. Booleova algebra, kombinační obvody (úplně určená funkce více proměnných) x sekvenční obvody (stavové automaty Mealy, Moor).
- 2. Základní struktura na tranzistorové úrovni logických obvodů v bipolárních technologiích AND, NAND, NOR, OR.
- 3. Dynamické parametry obvodů v bipolárních technologiích, vstupní, výstupní a převodní charakteristiky.
- 4. Základní struktura na tranzistorové úrovni logických obvodů v unipolárních technologiích invertor, AND, NAND, NOR, OR.
- 5. Dynamické parametry obvodů v unipolárních technologiích, vstupní, výstupní a převodní charakteristiky, logické obvody ACT, HC, AHC, ALVC. Vliv nízkého napájecího napětí na chování digitálních obvodů.
- 6. Paměťové obvody rozdělení pamětí, vlastnosti, typy, struktura. DRAM(1T), SRAM (6T), EEPROM, FLASH (SLC, MLC, TLC, PLC). Popište základní princip jednotlivých typů pamětí a jejich strukturu na tranzistorové úrovni.
- 7. Zobrazovací prvky, popis technologií LCD, OLED, plazma, elektronický inkoust, QLED. Základní struktury, popis funkce a srovnání výhod a nevýhod jednotlivých technologií.
- 8. Programovatelné logické obvody CPLD, FPGA, struktury, rozdíly, použití, výhody, nevýhody
- 9. Digitální signálové procesy, základní architektury, systém zpracování instrukcí (CISC, RISK, VLIW, CLIW), nástroje k dosažení vysokého výkonu DSP procesorů. ARM architektura, charakteristika a základní vlastnosti.

3 MPC-VSK

- 1) Vybrané pojmy a fyzikální principy Elektronické hladiny a energetické pásové diagramy, vlastní a nevlastní vodivost, Nábojová neutralita, Fermiho hladina, transportní jevy, pohyblivost nosičů, nerovnovážné jevy.
- 2) Vybrané pojmy a fyzikální principy Vedení proudu v polovodičích, drift, difúze, generace a rekombinace nosičů, nábojová neutralita versus termodynamická rovnováha.
- 3) PN Dioda PN přechod, dioda, VA charakteristika, elektrostatické řešení PN přechodu, Poissonova rovnice, lineární a strmý PN přechod.
- 4) PN Dioda oblast prostorového náboje, proudy PN přechodem v propustném směru, proudy PN přechodem v závěrném směru, elektrické průrazy PN přechodu.
- 5) Přechod kov-polovodič, Schottkyho dioda Srovnání činnosti Schottkyho diody s diodou PN, pásový diagram Schottkyho diody, elektrostatické řešení Schottkyho diody, VA charakteristika, použití.
- 6) Bipolární tranzistor Fyzikální princip bipolárního tranzistoru, pásový diagram, VA charakteristiky a základní parametry bipolárního tranzistoru, proudová bilance tranzistoru, Gumellovy grafy, Beta, Drift tranzistor.
- 7) Bipolární tranzistor Efekty limitující činnost bipolárního výkonového tranzistoru Kirkův efekt, Earlyho efekt, Websterův efekt, vliv odporu aktivní báze na funkci tranzistoru (crowding), průrazy u bipolárního tranzistoru a bezpečná operační oblast (SOA), aspekty ovlivňující proudový zisk, použití.
- 8) MIS Dioda Ideální MIS dioda, pásový diagram, akumulace, ochuzení, inverze, hluboké ochuzení, CV křivky, popis, podmínka rovných pásů (flat band), odezva MIS kapacity na rychlou změnu náboje na hradle.
- 9) MIS Dioda Srovnání kondenzátoru, PN diody a MIS diody, vliv světla, tepla a frekvence na CV křivku. Porovnání reálné a ideální MIS diody.
- 10) Tranzistor řízený elektrickým polem MOSFET Princip činnosti, klasifikace MOS tranzistorů podle typu kanálu a módu činnosti, činnost tranzistorů v lineární a saturační oblasti, VA charakteristiky v lineární a saturační oblasti.
- 11) Tranzistor řízený elektrickým polem MOSFET délková modulace kanálu, "pinchoff" bod, prahové napětí, body efekt, použití tranzistoru.
- 12) Tranzistor řízený elektrickým polem JFET Princip činnosti, VA charakteristiky v lineární a saturační oblasti, odpor kanálu, saturační napětí, strmost, kanálová vodivost, použití tranzistoru.
- 13) Integrita hradlového oxidu Módy průrazu oxidu, oxidové defekty, intrinzický a extrinzický průraz, perkolační model průrazu, injekční mechanizmy, proudy tenkým dielektrikem, rozdělení dielektrických průrazů.
- 14) Injekce horkých elektronů (HCI) Injekce horkých nosičů v MOS tranzistorech, horká a studená injekce, princip degradačního mechanizmu při injekci horkých nosičů a metody jeho eliminace.

4 MPC-NAI

- 1) DVOJRAMPOVÝ OSCILÁTOR S VCO CHARAKTERISTIKOU Nastavení střídy oscilátoru, výpočet kmitočtu oscilátoru, nastavení minimální a maximální frekvence oscilátoru s ohledem na řídící napětí
- 2) MANAGEMENT NAPÁJECÍHO NAPĚTÍ INTEGROVANÉHO OBVODU UVLO (řízení obvodu pomocí vstupního napájecího napětí, komparace vstupního napětí), Power on Reset (UV signál), realizace a výpočet nastavení komparačních úrovní
- 3) PRINCIP VYPÍNACÍ OCHRANY ZAŘÍZENÍ TYPU LATCH při chybovém signálu nastavení doby zpoždění, reset pomocí signálu UV
- 4) ZÁKLADY A TEORIE PŘESNÉHO NÁVRHU S OHLEDEM NA SOUBĚH PARAMETRŮ PRVKŮ INTEGROVANÉHO OBVODU Normální rozložení, Gaussova křivka, směrodatná odchylka, metoda Monte Carlo, princip superpozice (příklad součtu výstupních proudů z proudových zrcadel zatížených chybou souběhu)
- 5) ZÁKLADNÍ VZTAHY PRO VÝPOČET CHYB V ANALOGOVÝCH OBVODECH princip superpozice, celková chyba součtu a součinu dvou chybových veličin, přepočet chyb v obvodu diferenčního zapojení (výpočet vstupní napěťové nesymetrie komparátoru s BJT při známé chybě saturačního proudu vstupních tranzistorů)
- 6) PŘESNÁ TRANZISTOROVÁ DVOJICE souběh, proudové zrcadlo, diferenční stupeň, vliv rozměrů MOS tranzistorů na přesnost, Pelgromova rovnice
- 7) PŘESNÝ DIFERENCIÁLNÍ STUPEŇ (MOS/bipolar, odporová zátěž, aktivní zátěž) Analýza, pravidla přesného návrhu, ekvivalentní vstupní ofset, proudová nesymetrie transkonduktačního diferenčního stupně, výstupní napěťová nesymetrie zesilovače a jejich vztahy
- 8) PŘESNÝ DVOUSTUPŇOVÝ OPERAČNÍ ZESILOVAČ základní koncept přesného návrhu zesilovače, vstupní bipolární stupeň, princip eliminace chyby, postup návrhu
- 9) ŠUM Definice šumové hustoty a integrální hodnoty šumu a jejich vzájemný vztah, korelovaný a nekorelovaný příspěvek šumu, šumová charakteristika aktivních prvků (bílý a 1/f šum)
- 10) ŠUM ODPORU, ŠUM MOS TRANZISTORU základní charakteristiky a rovnice pro výpočet, vliv parametrů odporů a MOS, ekvivalentní vstupní šum MOS tranzistoru, ekvivalentní vstupní šum MOS zesilovače
- 11) ŠUM PN PŘECHODU, ŠUM BJT Zdroje šumu bipolárního tranzistoru, výpočet výstupního šumu jednoduchého proudového zrcadla
- 12) ZÁKLADNÍ KONCEPT NÍZKOŠUMOVÉHO NÁVRHU principy návrhu nízkošumového CMOS proudového zrcadla, principy návrhu CMOS nízkošumového diferenčního zesilovače

5 MPC-MTE

- 1) Pasty pro hybridní integrované obvody složení a význam jednotlivých složek, příprava a míchání past.
- 2) Sítotisk popis technologie depozice TLV past, parametry procesu, následné tepelné zpracování vrstev.
- 3) Vlastnosti tlustovrstvých rezistorů vysvětlete význam TCR, VCR, rozdíl mezi TCR a teplotní stabilitou, výkonová zatížitelnost.
- 4) Metoda výroby keramických substrátů (Tape casting) popis procesu, cílové aplikace, typy keramických substrátů a jejich parametry.
- 5) Základní porovnání parametrů tenko a tlusto vrstvové technologie, např. materiály, tlouška, rozlišení, TCR, teplotní stabilita a další.
- 6) Kontaktování polovodičových čipů popis základních metod, materiály, faktory působící na kvalitu spoje.
- 7) Leaching popis, příčiny a předcházení jevu, význam intermetalických sloučenin v pájeném spoji.
 - 8) Pájecí pasty základní složení, srovnání olovnatých a bezolovnatých slitin, tavidla.
- 9) Šablonový tisk popis depozice pájecích past, parametry procesu a šablony, čištění šablony.
- 10) Nastavování pájecích profilů pro BGA a QFN komponenty termodesky, vztah teolotního profilu k parametrům DPS a pájecím slitinám, specifika pro různé způsoby ohřevu.
- 11) Porovnání metod pájení přetavením z pohledu přestupu tepla výhody a nevýhody jednotlivých metod se zaměřením na výrobu a opravu elektronických sestav.
- 12) Montáž a opravy BGA a QFN pouzder popis pouzder, technologie montáže a opravy se zaměřením na odlišnosti uvedených jednotlivých pouzder.
- 13) Ochrana proti ESD vysvětlete důvod ochrany polovodičových součástek, popište specifika při práci s citlivými součástkami, balení a skladování.
- 14) Ochrana proti ESD II indikace nebezpečného náboje na pracovišti, eliminace nebezpečného náboje, materiály vhodné do výrobního prostředí citlivého na ESD.
- 15) Tepelný management význam pro pouzdření, způsoby šíření tepla, náhradní tepelný obvod pouzdra s tranzistorem, analogie mezi elektrickými a tepelnými veličinami.

6 MPC-TVP

- 1. Převodníky AD a DA základní princip, blokové schéma, základní statické a dynamické parametry, úloha v řetězci zpracování dat.
- 2. Obvody pro předzpracování signálu důvody použití, využití multiplexeru a demultiplexeru, invertované a neinvertované sítě, diferenční sítě příklady zapojení funkce.
- 3. Filtrační obvody funkce, příklady realizací, důvody použití v převodnících, aproximační charakteristiky, přesné filtry.
- 4. Vzorkovací obvody S/H a T/H obvody rozdíly, funkce, základní parametry, příklady realizací.
- 5. Referenční zdroje napětí a proudu jednoduché reference, reference řízené prahovým napětím tranzistoru, bandgap reference, výhody, nevýhody, teplotní závislost, stabilita.
- 6. Paralelní převodníky DA základní zapojení a funkce, využití sítě R-2R a modifikace, váhové sítě, typičtí představitelé.
- 7. Sériové převodníky DA základní zapojení a funkce, využití kapacitorů v síti, příklady využití.
- 8. Převodníky AD s vysokými vzorkovacími kmitočty komparační, řetězové základní zapojení a funkce, příklady využití.
 - 9. Převodníky AD typu SAR a integrační základní zapojení a funkce, příklady využití.
 - 10. Převodníky sigma-delta základní zapojení a funkce, příklady využití.
 - 11. Testování převodníků statické a dynamické testy.